2014B1599

# X 線吸収分光法による Mo/Ho 共添加 BaTiO<sub>3</sub>の局所構造解析 Local Structure Analysis of Molybdenum/Holmium Co-doped BaTiO<sub>3</sub> by using X-ray Absorption Spectroscopy

# <u>小形 曜一郎</u>, 龍 穰, 志村 哲生, 岩崎 誉志紀 Yoichiro Ogata, Minoru Ryu, Tetsuo Shimura, Yoshiki Iwazaki

# 太陽誘電(株) Taiyo Yuden Co., Ltd.

金属Niを内部電極とする積層セラミックコンデンサ(Ni-MLCC)の信頼性向上のため誘電体材料 BaTiO<sub>3</sub>に微量添加した Mo/Ho の局所構造を解析するため,X線吸収分光実験を行った。得られた 吸収微細構造(XAFS)の解析より,Mo は BaTiO<sub>3</sub>の Ti を部分置換し,MoO<sub>6</sub>八面体が *m*3*m* より低い 対称性であること,および還元焼成時に Mo(VI)から Mo(IV)近くに価数変化することが明らかにな った。

キーワード: BaTiO<sub>3</sub>, 誘電体, Ni-MLCC, 還元焼成, XAFS

## 背景と研究目的:

金属 Ni を内部電極とする積層セラミックコンデンサ(Multilayer ceramic capacitor; MLCC)は数多 くのエレクトロニクス製品に使われているチップ型電子部品であり,BaTiO<sub>3</sub>(BT)セラミックスは Ni-MLCC を構成する主要な誘電体材料である。Ni-MLCC の製造では電極/誘電体の一体焼結プ ロセスにおいて Ni 酸化抑制のため還元雰囲気中で焼成するが,還元焼成により生成される BT 中 の酸化物イオン欠損の拡散が Ni-MLCC の信頼性低下の一因となるため,欠損を解消する目的で還 元焼成後に Ni が酸化しない程度の弱い酸化雰囲気で熱処理を行っている(再酸化)。しかし,再酸 化処理の酸化力が弱いため酸化物イオン欠損を完全には解消できない。したがって Ni-MLCC に用 いる BT には本質的に耐還元性が要求され,これまでに BT への耐還元性付与と誘電特性制御を目 的とした様々な微量元素添加による材料設計がなされている[1-6]。

これまでの MLCC 組成の検討から, バナジウム等のドナー元素添加により MLCC の寿命が向上 することが知られており[5][6], 同様に希土類添加により MLCC 信頼性が向上することも知られて いる。希土類である Ho を添加した BT については局所構造と特性の関連性がよく調べられている が[2][4], ドナー元素/Ho 共添加 BT におけるドナーの効果はよく知られていない。したがって今 回はドナー元素として Mo に注目し, BT 中の Mo, Ho の局所構造と Ni-MLCC の電気特性との関 連付けを図るため, X 線吸収分光法による Mo, Ho の局所構造解析を試みた。

#### 実験:

BaCO<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub> 粉末を原料とし, 固相反応法により Mo 0.2 mol%添加 BT(MBT)を合成した。 MBT 粉末に Ho<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末 1.5 mol%, 高分子バインダー,有機溶媒を加えて混合してペーストを作製 し,それを薄いシート状にして乾燥することにより誘電体シートを得た。誘電体シート上に内部 電極となる Ni ペーストを印刷し,シートを積層し,プレスした。それらをカット成型し,成型体 を弱還元雰囲気で焼成し,得られた焼結体を再酸化処理した。以上のプロセスにて,還元焼成後 および再酸化後の焼結体を抜き出し,これに外部電極を塗布して Ni-MLCC 試料を得た。比較用と して MBT の替わりに Mo 無添加 BT を用いた試料も作製した。得られた Ni-MLCC の電気特性評 価として *I-V* 曲線測定および加速寿命試験を行ったところ, Mo/Ho 共添加 BT は Mo 無添加/Ho 添 加 BT よりも漏れ電流が若干悪化したが,寿命の向上が見られた。また, Mo/Ho 共添加 BT は還 元焼成後と再酸化後で寿命に変化はなかったが,漏れ電流が低下した。

X 線吸収分光測定用試料として,誘電体シート上に内部電極を印刷せずに上述のプロセスを経たものをカット成型後,還元焼成後,再酸化後にそれぞれ抜き出して粉砕し,粉末試料を得た。 また,Mo 価数解析の参照試料として Mo 箔,MoO<sub>2</sub>粉末,MoO<sub>3</sub>粉末を準備した。ビームライン BL14B2 にて Mo K 吸収端および Ho L<sub>III</sub> 吸収端近傍の X 線吸収スペクトルを測定した。モノクロ メーター結晶面として Mo K 端測定では Si(311)を, Ho L<sub>III</sub> 端測定では Si(111)を用いた。BT 試料は 19SSD 検出器による蛍光法,標準試料は透過法で測定した。測定で得られた X 線吸収微細構造 (XAFS)の解析にはソフトウェア Athena [7]を用いた。

## 結果および考察:

カット成型後,還元焼成後,再酸化後 Mo/Ho 共添加 BT および参照試料 Mo, MoO<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub> の Mo K 吸収端 XANES の測定結果を図 1 に示す。規格化  $\mu$  = 0.7 にて吸収端のエネルギーシフトを比較 すると,カット後では MoO<sub>3</sub> と等しい吸収端が還元後には MoO<sub>2</sub> に近づいており,還元焼成によ り BT 中の Mo のイオン価数が 6+から 4+近くに変化していることが明らかとなった。また,再酸 化後は還元後から XANES の変化がなく,再酸化処理は誘電体バルクに対しては影響がないこと が示唆される。なお,20010 eV あたりに見られる pre-edge ピークは MoO<sub>4</sub> 四面体の形成,または MoO<sub>6</sub> 八面体の対称性が  $m\bar{3}m$  よりも低い場合に現れると報告されている[8]が,今回の結果につい ては後述する。Mo K 端 EXAFS 振動  $k^3\chi(k)$ の Fourier 変換(k = 2.5–10.5 Å<sup>-1</sup>)により求めた動径構造関 数(RSF)を図 2 に示す。図中矢印で示す最近接のピークは Ti サイトへの置換に対応している。し たがって,XANES の pre-edge は MoO<sub>6</sub> 八面体の歪みによるものと考えられる。RSF の最近接ピークを比較すると,還元後,再酸化後はピーク位置がカット後より右にシフトしており,Mo 価数の 変化により Mo-O 原子間距離が伸びたことを表している。

以上の結果より, Mo/Ho 共添加 BT 中の微量 Mo は Ti を部分置換し,還元焼成により Mo(VI) から Mo(IV)近くに変化することが明らかになった。また,再酸化処理では Mo の状態は変化せず,還元後と再酸化後の電気特性の差異(漏れ電流の変化)は Mo/Ho 共添加 BT バルクに起因しないことが判明した。Ho L<sub>III</sub>端の XAFS も測定したが,還元後と再酸化後の間に目立った差異は見られなかった。



図 1. カット成型後,還元焼成後,再酸化後の Mo/Ho 共添加 BaTiO<sub>3</sub> および Mo, MoO<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub> の Mo K 吸収端 XANES。



図 2. カット成型後,還元焼成後,再酸化後の Mo/Ho 共添加 BaTiO<sub>3</sub>の Mo K 吸収端 EXAFS より得られた動径構造関数。矢印で示したピークは Mo が Ti サイトに置換されたとき の Mo-O 結合に対応し,還元焼成により原子間距離が伸びている。

## 今後の課題:

EXAFS データを解析し、最近接原子の結合距離を導出する。解析した局所構造と電気特性の関連について考察する。還元後と再酸化後の電気特性の差異については電極/誘電体界面の状態に起因すると予想されるため、電子顕微鏡レベルの小径プローブで界面の局所位置を特定して微量添加元素の電子構造や酸化物イオン欠損濃度を解析する手法が必要である。

## 参考文献:

- [1] H. Saito et al., Jpn. J. Appl. Phys. 30, 2307 (1991).
- [2] Y. Okino et al., Jpn. J. Appl. Phys. 33, 5393 (1994).
- [3] P. Hansen et al., J. Electroceram. 2, 193 (1998).
- [4] H. Kishi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 39, 5533 (2000).
- [5] T. Shibahara et al., Jpn. J. Appl. Phys. 50, 09NC12 (2011).
- [6] H. Natui et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 09LC09 (2012).
- [7] B. Ravel, M. Newville, J. Synchrotron Rad. 12, 537 (2005).
- [8] H. Aritani et al., J. Phys. Chem. 100, 5440 (1996).